



表面贴装型时钟晶体振荡器 KC2520B-C1系列

CMOS/ 1.8V~3.3V/ 2.5×2.0mm



RoHS指令对应产品

■特点

- 小型低背陶瓷封装
2.5(L)×2.0(W)×0.7(H)mm(Typ.)
- 用缝口密封的高可靠性
- CMOS输出
- 电源电压 可以用于这些规格 1.8/ 2.5/ 3.3V
可对应广泛的电源电压范围 1.6~3.63V
- 低电流消耗类型
- 可对应高频率(~125MHz)

■频率容差(Overall)

容差 コード × 10 ⁻⁶	工作温度范围 (°C)	备注
0 ± 50	-10 ~ +70	标准规范
S ± 30		
U ± 25	-40 ~ +85	工作频率敬请咨询。
F ± 100		
G ± 50		
6 ± 50	-40 ~ +105	

■型号表示方法

KC2520B 25.0000 C 1 □ E 00

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①系列名称
- ②输出频率
- ③输出形式(CMOS)
- ④电源电压(可以用于这些规格 1.8V、2.5V、3.3V)
- ⑤频率容差(参见左表)
- ⑥对称/INH功能(45/ 55%)
- ⑦个别规格(产品目录以00标示)

包装方式(载带包装 2000个/卷盘)

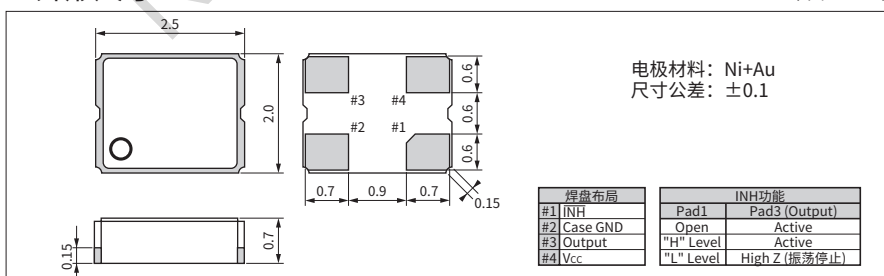
■规格

项 目	记 号	条 件	规 格		单 位	
			Min.	Max.		
输出频率范围*	fo		80.0001	125	MHz	
频率容差	f _{tol}	起始偏差、工作温度范围内的温度特性、电源电压变化、负载容量变化、长期变化(1年@25°C)、包括振动和冲击	Temp.: -40 ~ +85°C	-100	+100	×10 ⁻⁶
			Temp.: -10 ~ +70°C / -40 ~ +85°C / -40 ~ +105°C	-50	+50	
			Temp.: -10 ~ +70°C	-30	+30	
储存温度范围	T _{stg}	标准规范	-55	+125	°C	
工作温度范围	T _{use}	选项	-10	+70	°C	
			-40	+85		
最大的额定电压 电源电压	— V _{cc}	80<fo≤125MHz	-0.3	+4.0	V	
			+1.6	+3.63		
电流消耗 (最大负载时/ 1.6≤V _{cc} ≤2.0V)	I _{cc}	80<fo≤125MHz	—	11.0	mA	
电流消耗 (最大负载时/ 2.0<V _{cc} ≤2.8V)		80<fo≤125MHz	—	14.0		
电流消耗 (最大负载时/ 2.8<V _{cc} ≤3.63V)		80<fo≤125MHz	—	17.0		
待机时电流	I _{std}		—	10	μA	
波形对称	SYM	@50% V _{cc}	45	55	%	
上升/下降时间 (10%V _{cc} ~90%V _{cc} 最大负载时)	Tr/ Tf	1.6≤V _{cc} ≤3.63V/ 80<fo≤125MHz	—	4.0	ns	
L电平输出电压	VoL	IoL=4mA	—	10% V _{cc}	V	
H电平输出电压	VoH	IoH=-4mA	90% V _{cc}	—	V	
输出负载条件(CMOS)	L CMOS	CMOS Output	—	15	pF	
L电平输入电压	V _{IL}		—	30% V _{cc}	V	
H电平输入电压	V _{IH}		70% V _{cc}	—	V	
禁用时间	t _{dis}		—	100	ns	
启用时间	t _{ena}		—	5	ms	
振荡启动时间	t _{str}	最小动作电压为0sec.	—	10	ms	
1Sigma Jitter	J _{Sigma}	使用Wavecrest SIA-3000测量	80<fo≤125MHz	—	4	ps
Peak to Peak Jitter	J _{PK-PK}	使用Wavecrest SIA-3000测量	80<fo≤125MHz	—	40	ps

所有的电气特性是以最大负载时, 并在工作温度范围内为条件。 * 输出频率超出该范围的, 敬请咨询。

■外形尺寸

(单位: mm)



■推荐焊盘图案

(单位: mm)

